



1. 基本特性

ROM: 1K x 14 位

RAM: 25 x 8 位

堆栈 : 2 级

I/O 口 : 12 个 I/O

定时器/计数器 : 8bits x1 (TMR0)

预分频器 : 8 位

Watchdog 定时器 : 在芯片上基于内部 RC 振荡器的 watchdog , 最短周期是 20MS; 用户可通过使用预分频器使 watchdog 溢出周期达到 2.6S。

上电复位

复位定时器 : 20 mS (5V)

四种外部振荡模式 : RC, LP, NT, HS 晶振

工作电压 : 2.2V~5.5V

指令集 : 79 个

复位向量 : 3FFH



2. 脚位定义

PA ₂	1		18	PA ₁
PA ₃	2		17	PA ₀
RTCC	3		16	OSC ₁
RESETB/VPP	4		15	OSC ₂
VSS	5		14	VDD
PB ₀	6		13	PB ₇
PB ₁	7		12	PB ₆
PB ₂	8		11	PB ₅
PB ₃	9		10	PB ₄

封装方式：DIP & SOP.

PA ₂	1		20	PA ₁
PA ₃	2		19	PA ₀
RTCC	3		18	OSC ₁
RESETB/VPP	4		17	OSC ₂
VSS	5		16	VDD
VSS	6		15	VDD
PB ₀	7		14	PB ₇
PB ₁	8		13	PB ₆
PB ₂	9		12	PB ₅
PB ₃	10		11	PB ₄

封装方式：SSOP.

RTCC	1		14	OSC ₁
RESETB/VPP	2		13	OSC ₂
VSS	3		12	VDD
PB ₀	4		11	PB ₇
PB ₁	5		10	PB ₆
PB ₂	6		9	PB ₅
PB ₃	7		8	PB ₄

封装方式：DIP & SOP.



脚位描述

脚位名称	I/O	描述
RTCC	I	外部时钟输入到 TMR0 计数器
PA ₃₋₀	I/O	I/O 口
PB ₇₋₀	I/O	I/O 口
RESETB/VPP	I	系统复位信号 & VPP (高电压) 输入 1 低电压：复位模式 2 高电压：编程模式
OSC ₁	I	振荡器输入
OSC ₂	O	振荡器输出
VDD	P	电源输入
VSS	P	接地输入

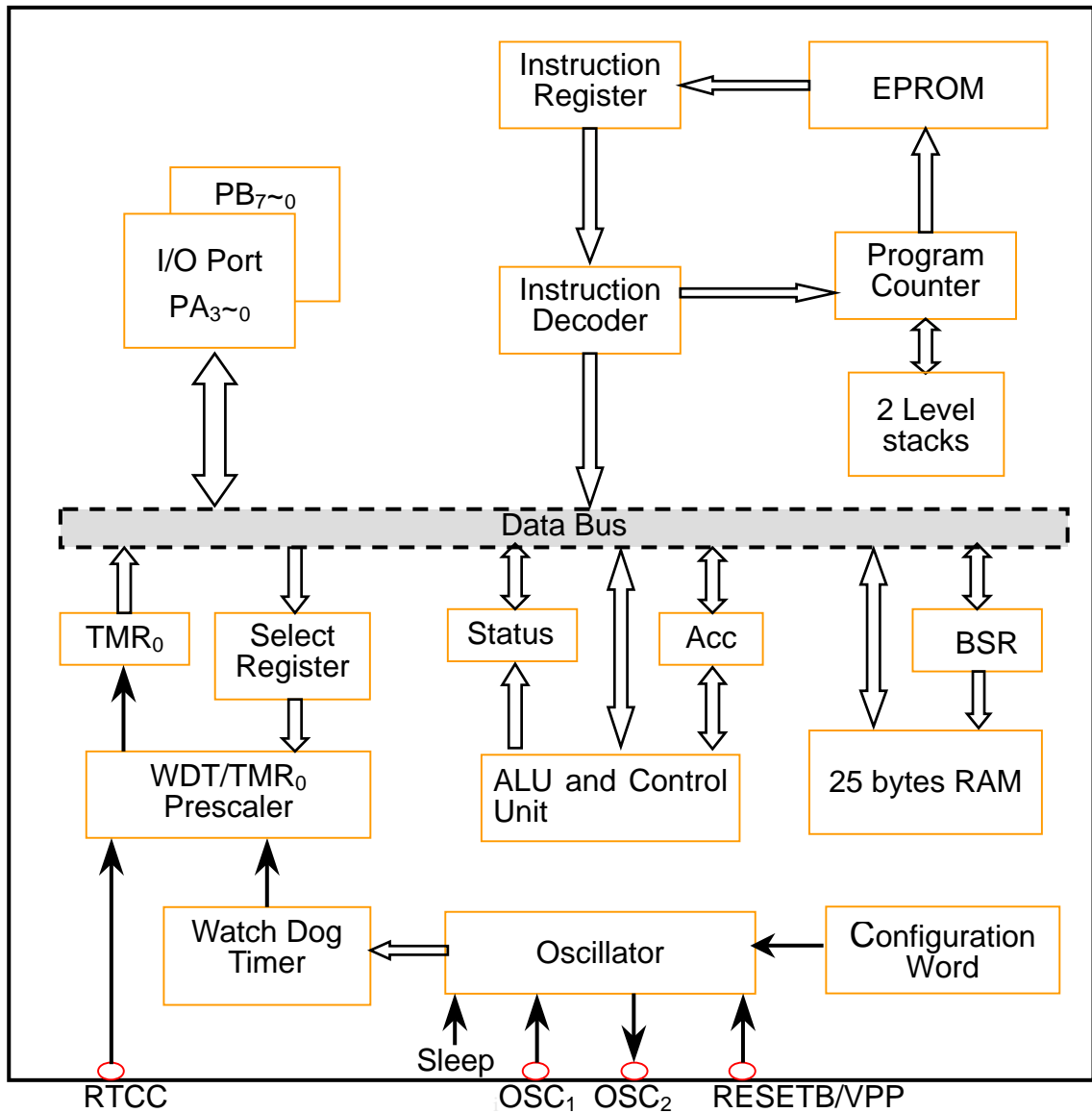
I: 输入; O: 输出; I/O: Bi-方向; P: 电源

3. 控制寄存器

Name	Addr	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
CONFIG (Instruction)						CPT	WDTE	FOSC ₁	FOSC ₀
SELECT				SUR ₀	EDGE ₀	PSA	PS ₂	PS ₁	PS ₀
IAR	\$00				A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
TMR0	\$01	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
PC	\$02	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
STATUS	\$03			SA ₀	TOB	PDB	Z	DC	C
BSR	\$04				D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
I/O Port _A	\$05					PA ₃	PA ₂	PA ₁	PA ₀
I/O Port _B	\$06	PB ₇	PB ₆	PB ₅	PB ₄	PB ₃	PB ₂	PB ₁	PB ₀



4. 系统图表





5. 存储器映象

TM58PC10 存储分为程序存储器和数据存储器。

5.1 程序存储器

TM58PC10允许直接寻址1K存储器任何地址，而不受页面大小限制。另外，lcall和lgoto指令可提供灵活的寻址模式。

TM58PC10有一个可访问1K空间的10位程序计数器。如果访问地址超过1K，地址仍会映象到1K存储器，也就是1K+M将会映象到M。在复位向量位置加一个NOP指令会导致在地址000h处重新启动。ROM结构如图5-1所示。

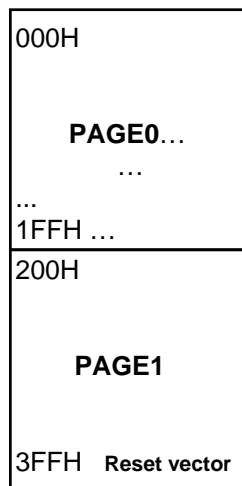


图 5-1 ROM 结构



configuration word 位于 800H , 包含振荡选择、WDT 允许、编码保护。(图 5-2).

Bit	Symbol	Description			
		Bit1	Bit0	OSC Type	Resonance Frequency
1~0	FOSC ₁ ~FOSC ₀	0	0	LP (low speed)	32~200K Hz
		0	1	NT (Normal speed)	200K~10M Hz
		1	0	HS (high speed)	10~20M Hz
		1	1	RC	32K ~ 6M Hz
2	WDTE	WDTE: Watchdog enable/disable control 1: WDT enable 0: WDT disable			
3	CPT	CPT: Code Protection bit 1: OFF 0: ON			

图 5-2 Configuration Word

5.2 数据存储

数据存储是由专用的寄存器和通用随机存储器组成的。

TM58PC10有25个通过直接或间接寻址存取数据的通用寄存器。专用功能寄存器包含程序计数器(PC), 定时器(TMR0)寄存器, 状态寄存器, bank选择寄存器, I/O寄存器。此外, TM58PC10有3个辅助寄存器: 间接寻址寄存器(IAR)、选择寄存器(Select)、I/O定向寄存器(IODIR)。寄存器映象如图5-3所示。

	Bank0
00h	IAR
01h	TMR0
02h	PC
03h	STATUS
04h	BSR
05h	PORTA
06h	PORTB
9+16=25	通用寄存器 07 - 0F
	通用寄存器 10 - 1F

图 5-3 寄存器映象



- A. 间接寻址寄存器不是物理寄存器，而是以间接寻址来辅助bank选择寄存器。访问间接寻址寄存器的任何指令实际上是映象到bank选择寄存器所指的地址。因为间接寻址寄存器不是物理线路，用户读取间接寻址寄存器本身(BSR=00H)将总是返回数据00h。写间接寻址寄存器本身等同于NOP指令。
- B. 选择寄存器用来控制WDT和TMR0。在数据存储器中它不分配一个唯一的地址，而通过选择指令只设置控制位，也就是说，它是只写寄存器。累加器的内容将会通过执行选择指令被送到可选寄存器。如果程序未设置选择寄存器，默认值是3FH。如图5-4所示说明如何设置选择寄存器。

位	符号	描述				
2~0	PS ₂ ~PS ₀	PS ₂	PS ₁	PS ₀	TMR0 rate	WDT rate
		0	0	0	1:2	1:1
		0	0	1	1:4	1:2
		0	1	0	1:8	1:4
		0	1	1	1:16	1:8
		1	0	0	1:32	1:16
		1	0	1	1:64	1:32
		1	1	0	1:128	1:64
1	1	1	1:256	1:128		
3	PSA	PSA: 预分频器分配位 1: 分配到 WDT 的预分频器 0: 分配到TMR0的预分频器				
4	EDGE ₀	EDGE ₀ : TMR0源信号边沿控制位 1:外部时钟信号从高电平到低电平时，定时器加1。 0:外部时钟信号由低电平到高电平时，定时器加1。				
5	SUR ₀	SUR ₀ : TMR0时钟源位 1: RTCC时钟输入 0: (系统时钟)/4 或内部指令周期				

图 5-4 选择寄存器

- C. I/O方向控制寄存器与选择寄存器相似，也是只写寄存器。设置一个I/O口作为输入，相应的方向控制位必须是高位，同样地零代表输出。任何方向控制位可用IODIR指令作为输入或输出单独地被编程。如果寄存器不被编程，所有的I/O口将总保持输入模式。



- 程序计数器是10位二进制计数器，除了在下方的条件下，每个指令周期，计数器都加1。
 1. call, goto, lgoto, lcall: 标志将移到程序计数器。
 2. retla, ret: 堆栈顶端值将弹出到程序计数器。

- 当程序计数器到下一页时自动加1。值得注意的是：状态寄存器中页选位不会同时被改变。除非页选位在程序中已更新，否则GOTO，CALL或MOVAM 02H将会返回到原来的页。为了减少程序的复杂性，TM58PC10提供2个指令益于子程序调用和分步处理，即LCALL，LGOTO。LCALL和LGOTO可寻址ROM任何地址，但不必设定页选位。CALL和GOTO的操作数分别是8位和9位，因此需要特殊位(即页选位)寻址整个存储器。然而LCALL和LGOTO有10位易于寻址ROM所有空间的操作数。

- TMR0是8位二进制计数器/定时器，该寄存器通过RTCC脚的外部信号边沿变化或内部指令周期加1。它具有如下特性：
 - A. 可读可写
 - B. 2个内部时钟同步
 - C. 可通过设置选择寄存器使用可编程预分频器。其他详细说明在下一章会有具体描述。

- 状态寄存器包含页选位、超时位、掉电位和ALU状态。值得注意的是 \overline{TO} 和 \overline{PD} 是受硬件控制的，而不会被程序改变。



位	符号	描述	
0	C	进位位与借位	
		加指令	减指令
		1: 从 MSB 进位 0: 无进位	1: 无借位 ^(注1) 0: 从MSB借位
1	DC	四位进位位与四位借位	
		加指令	减指令
		1: 从低四位进位 0: 无低四位进位	1: 无低四位借位 0: 从低四位借位
2	Z	零标志位： 1: 逻辑操作结果是0 0: 逻辑操作结果非0	
3	\overline{PD}	掉电标志位： ^(注2) 1: 上电后或执行CLRWDT指令后，结果为1 0: 执行SLEEP指令后，结果为0	
4	\overline{TO}	溢出标志位 1: 上电后或执行CLRWDT或SLEEP指令后，结果为1 0: WDT时间溢出时，结果为0	
5	SA ₀	页位置	
		0 1	Page ₀ (000H~1FFH) Page ₁ (200H~3FFH)

图 5-5 状态寄存器

注1: 减指令的执行是通过与减数的二进制补码相加来实现的，C=1代表结果是正数。C位与借位之间的关系如图5-5-1所示。

B0H – 50H										50H – B0H									
	C	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		C	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
+		1	0	1	1	0	0	0	0	+		0	1	0	1	0	0	0	0
=	1	0	1	1	0	0	0	0	0	=	0	1	0	1	0	0	0	0	0

图 5-5-1



注 2: \overline{TO} 和 \overline{PD} 位是低有效，可决定复位的不同原因。图 5-5-2 举例说明了不同复位后 \overline{TO} 和 \overline{PD} 的值。

\overline{TO}	\overline{PD}	复位结果
0	0	从睡眠模式 WDT 超时
0	1	从一般模式 WDT 超时
1	0	从睡眠模式 RESETB 输入“低”复位
1	1	上电复位
不变	不变	从一般模式 RESETB 输入低复位

图 5-5-2

Bank 选择寄存器与间接寻址寄存器间接地访问数据存储器。Bank 选择寄存器的 bit4~bit0 被用来选择数据存储器，这些地址将映象到 00H~1FH 00H~0FH(Bank0)，地址映象如图 5-6 所示：

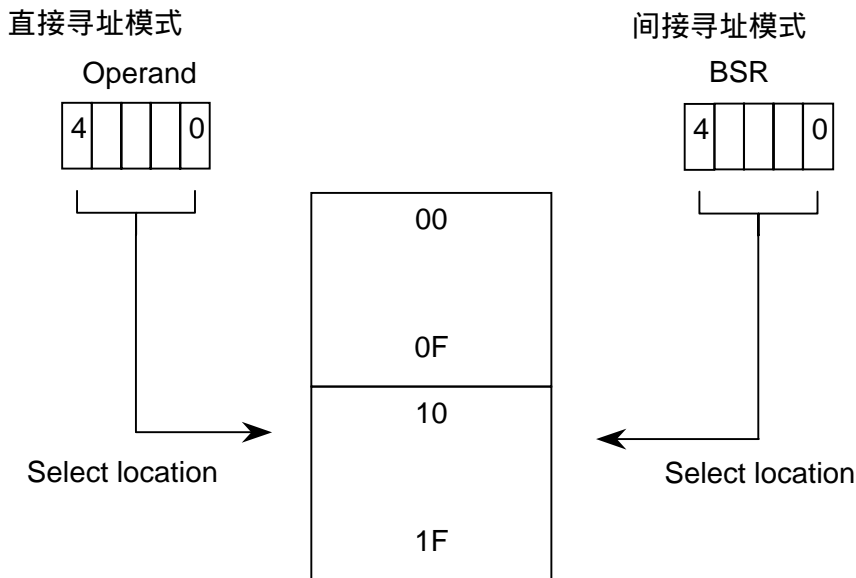


图 5-6 直接寻址与间接寻址映象

- Port A~B 是可编程的 I/O 口。值得注意的是，即使 I/O 脚是输出模式，读 I/O 指令也总是读 I/O 脚。复位时所有 I/O 脚都被置成输入模式，直到 IO 寄存器被改变。



6. 功能描述

6.1 TMR0 与 Watchdog 定时器

图 6-1 是 TMR0/WDT 预分频器的方框图。如图所示，预分频器寄存器可以是 TMR0 的预分频器或是 WDT 的后分频器。

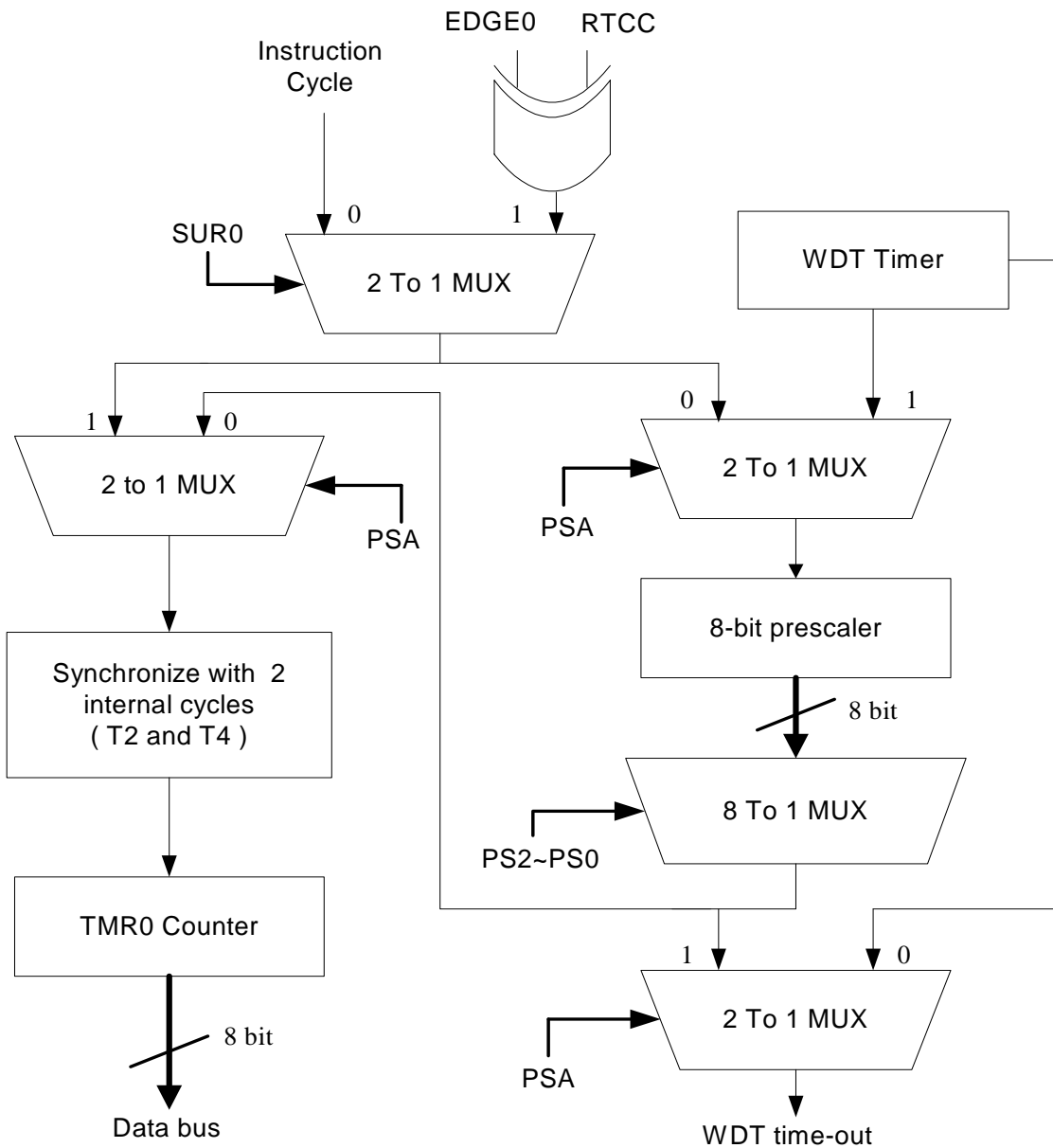


图 6-1 TMR0/WDT 预分频器方框图



TMR0 是一个 8 位定时器/计数器。TMR0 的时钟源可以来自指令时钟或外部时钟。

- A. 选择指令时钟，选择寄存器的 SUR0 位应该清零。当未使用预分频器时，TMR0 将会在每个指令周期加 1。
- B. 选择外部时钟，选择寄存器的 SUR0 位应该置 1。在该模式，TMR0 根据 EDGE0 来决定在外部时钟的上升沿或下降沿加 1。当 TMR0 选择外部时钟时，应当注意外部时钟将与内部时钟同步进行。TM58PC10 通过内部时钟的 T2 和 T4 采样来同步外部时钟。如果外部脉冲小于 2 个内部时钟周期，那么脉冲可能会被忽略。也就是说，外部时钟必须至少在 2 个内部时钟周期保持稳定状态。

WDT 计数器是一个 8 位二进制计数器，WDT 时钟源是由一个独立的不需要任何外部时钟的 RC 振荡器芯片提供的。因此，即使芯片已进入睡眠状态，WDT 仍将计数。若 WDT 超时，系统将重激活并将超时标志位(状态寄存器的 bit4)清 0。WDT 超时时间会随温度、电源电压的变化而变化，并且可通过设置预分频器来改变超时时间。通过设置 PS2~PS0 为“111”，最大分频率可达 1 : 128。

通过 PSA 位预分频器可分配到 TMR0 或 WDT。WDT 或 TMR0 不能同时使用预分频器。当预分频器从 TMR0 变成 WDT，或从 WDT 变成 TMR0 时，执行下面的例子(2-3)。下面的例子可以避免超时复位。

当预分频器被分配到 WDT，“CLRWDT”和“SLEEP”指令将会清除预分频器和 WDT。当预分频器被分配到 TMR0，任何写到 TMR0 的指令都会清除预分频器。

```

Clrwdt
Clrm   TMR0   ; clear prescaler & TMR0
Movla  B'00xx1111'
Select
Clrwdt
Movla  B'00xx1xxx' ; set prescaler to
desired
    
```

例 1

预分频器从 TMR0 变成 WDT

```

Clrwdt   ; clear prescaler & WDT
Movla   B'00xx0xxx'
Select   ; set prescaler to TMR0
           ; with new rate
    
```

例 2

预分频器从 WDT 变成 TMR0



6.2 复位

当满足下列任意一个条件TM58PC10都可能复位：

- (1) 上电
- (2) RESETB/VPP脚输入一个负脉冲
- (3) WDT定时器超时复位(如果WDTE允许).

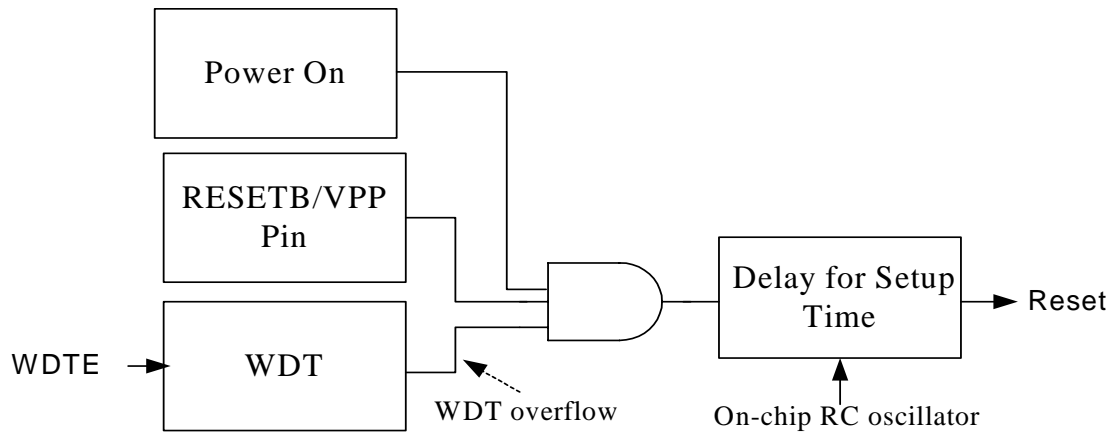


图 6-2 复位控制器

如图6-2所示，三个复位条件被列出。一般来说，我们称第一种情况为冷复位。冷复位的时间对于低速晶振和RC振荡器来说可能太短了，它们需要比激活时间长得多的时间。

注：激活时间大约20ms，激活时间随电源电压、process、温度变化而变化。

后两种情况被称为热复位。不同的复位对寄存器和随机 RAM 的影响也是不同的。 \overline{TO} 和 \overline{PD} 用来决定复位的类型。这两种复位的关系如图 6-3 所示。



Address	Name	Cold Reset	Warm Reset
N/A	Accumulator	xxxx xxxx	pppp pppp
N/A	IODIR	1111 1111	1111 1111
N/A	Select	--11 1111	--11 1111
00h	IAR	---- ----	---- ----
01h	TMR0	xxxx xxxx	pppp pppp
02h	PC	111 1111 1111	111 1111 1111
03h	STATUS	0001 1xxx	000? ?ppp
04h	BSR	111x xxxx	111p pppp
05h	PORTA	0000 xxxx	0000 pppp
06h	PORTB	xxxx xxxx	pppp pppp
	General Purpose RAM	xxxx xxxx	pppp pppp

6-3 RESET CONDITIONS

X: 未知的; P: 原来的数值 ; ?: 依据不同复位条件 ; -:不执行 , 清"0"



7. 指令集

Mnemonic Operands	Instruction Code (Advance)	Cycles	Status Affected	OP-code
ADDAM M, m	$(M) + (acc) \rightarrow (M)$	1	C, DC, Z	10 0101 1MMM MMMM
ADDAM M, a	$(M) + (acc) \rightarrow (acc)$	1	C, DC, Z	10 0101 0MMM MMMM
ANDAM M, m	$(M) \cdot (acc) \rightarrow (M)$	1	Z	10 0100 1MMM MMMM
ANDAM M, a	$(M) \cdot (acc) \rightarrow (acc)$	1	Z	10 0100 0MMM MMMM
ANDLA I	Literal $\cdot (acc) \rightarrow (acc)$	1	Z	11 1001 iiiii iiiii
BCM M, b0	Clear bit0 of (M)	1	None	00 1100 0MMM MMMM
BCM M, b1	Clear bit1 of (M)	1	None	00 1100 1MMM MMMM
BCM M, b2	Clear bit2 of (M)	1	None	00 1101 0MMM MMMM
BCM M, b3	Clear bit3 of (M)	1	None	00 1101 1MMM MMMM
BCM M, b4	Clear bit4 of (M)	1	None	00 1110 0MMM MMMM
BCM M, b5	Clear bit5 of (M)	1	None	00 1110 1MMM MMMM
BCM M, b6	Clear bit6 of (M)	1	None	00 1111 0MMM MMMM
BCM M, b7	Clear bit7 of (M)	1	None	00 1111 1MMM MMMM
BSM M, b0	Set bit0 of (M)	1	None	00 1000 0MMM MMMM
BSM M, b1	Set bit1 of (M)	1	None	00 1000 1MMM MMMM
BSM M, b2	Set bit2 of (M)	1	None	00 1001 0MMM MMMM
BSM M, b3	Set bit3 of (M)	1	None	00 1001 1MMM MMMM
BSM M, b4	Set bit4 of (M)	1	None	00 1010 0MMM MMMM
BSM M, b5	Set bit5 of (M)	1	None	00 1010 1MMM MMMM
BSM M, b6	Set bit6 of (M)	1	None	00 1011 0MMM MMMM
BSM M, b7	Set bit7 of (M)	1	None	00 1011 1MMM MMMM
BTMSC M, b0	If bit0 of (M) = 0, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0100 0MMM MMMM
BTMSC M, b1	If bit1 of (M) = 0, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0100 1MMM MMMM
BTMSC M, b2	If bit2 of (M) = 0, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0101 0MMM MMMM
BTMSC M, b3	If bit3 of (M) = 0, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0101 1MMM MMMM
BTMSC M, b4	If bit4 of (M) = 0, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0110 0MMM MMMM
BTMSC M, b5	If bit5 of (M) = 0, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0110 1MMM MMMM
BTMSC M, b6	If bit6 of (M) = 0, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0111 0MMM MMMM



BTMSC M, b7	If bit7 of (M) = 0, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0111 1MMM MMMM
BTMSS M, b0	If bit0 of (M) = 1, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0000 0MMM MMMM
BTMSS M, b1	If bit1 of (M) = 1, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0000 1MMM MMMM
BTMSS M, b2	If bit2 of (M) = 1, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0001 0MMM MMMM
BTMSS M, b3	If bit3 of (M) = 1, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0001 1MMM MMMM
BTMSS M, b4	If bit4 of (M) = 1, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0010 0MMM MMMM
BTMSS M, b5	If bit5 of (M) = 1, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0010 1MMM MMMM
BTMSS M, b6	If bit6 of (M) = 1, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0011 0MMM MMMM
BTMSS M, b7	If bit7 of (M) = 1, skip next instruction	1 + (skip)	None	00 0011 1MMM MMMM
CALL I	Call subroutine	2	None	11 0110 iiiiiiii
CLRA	Clear accumulator	1	Z	10 0001 0000 0000
CLRM M	Clear memory M	1	Z	10 0001 1MMM MMMM
CLRWDT	Clear watch-dog register	1	TO, PO	10 0000 0000 0001
COMM M, m	$\sim(M) \rightarrow (M)$	1	Z	10 0010 1MMM MMMM
COMM M, a	$\sim(M) \rightarrow (\text{acc})$	1	Z	10 0010 0MMM MMMM
DECM M, m	Decrement M to M	1	Z	10 0110 1MMM MMMM
DECM M, a	$(M) - 1 \rightarrow (\text{acc})$	1	Z	10 0110 0MMM MMMM
DECMSZ M, m	$(M) - 1 \rightarrow (M)$, skip if (M) = 0	1 + (skip)	None	10 0111 1MMM MMMM
DECMSZ M, a	$(M) - 1 \rightarrow (\text{acc})$, skip if (M) = 0	1 + (skip)	None	10 0111 0MMM MMMM
GOTO I	Goto branch	2	None	11 101i iiiiiiii
INCM M, m	$(M) + 1 \rightarrow (M)$	1	Z	10 1000 1MMM MMMM
INCM M, a	$(M) + 1 \rightarrow (\text{acc})$	1	Z	10 1000 0MMM MMMM
INCMSZ M, m	$(M) + 1 \rightarrow (M)$, skip if (M) = 0	1 + (skip)	None	10 1001 1MMM MMMM
INCMSZ M, a	$(M) + 1 \rightarrow (\text{acc})$, skip if (M) = 0	1 + (skip)	None	10 1001 0MMM MMMM
IODIR M	Set i/o direction	1	None	10 0000 0000 0MMM
IORAM M, m	(M) ior (acc) \rightarrow (M)	1	Z	10 1111 1MMM MMMM
IORAM M, a	(M) ior (acc) \rightarrow (acc)	1	Z	10 1111 0MMM MMMM
IORLA I	Literal ior (acc) \rightarrow (acc)	1	Z	11 0011 iiiiiiii



LCALL I	Call subroutine. However, LCALL can addressing 2K address	2	None	01 0iii iiiiiiii
LGOTO I	Go branch to any address	2	None	01 1iii iiiiiiii
MOVAM m	Move data form acc to memory	1	None	10 0000 1MMM MMMM
MOVLA I	Move literal to accumulator	1	None	11 0001 iiiiiiii
MOVMM, m	(M) → (M)	1	Z	10 0011 1MMM MMMM
MOVMM, a	(M) → (acc)	1	Z	10 0011 0MMM MMMM
NOP	No operation	1	None	10 0000 0000 0000
RET	Return	2	None	11 1111 0111 1111
RETI (note)	Return and enable INTM	2	None	11 1111 1111 1111
RETLA I	Return and move literal to accumulator	2	None	11 1100 iiiiiiii
RLM M, m	Rotate left from m to itself	1	C	10 1100 1MMM MMMM
RLM M, a	Rotate left from m to acc	1	C	10 1100 0MMM MMMM
RRM M, m	Rotate right from m to itself	1	C	10 1110 1MMM MMMM
RRM M, a	Rotate right from m to acc	1	C	10 1110 0MMM MMMM
SELECT	Set select register	1	None	10 0000 0000 0010
SLEEP	Enter sleep (saving) mode	1	TO, PO	10 0000 0000 0011
SUBAM M, m	(M)-(acc) → (M)	1	C, DC, Z	10 1010 1MMM MMMM
SUBAM M, a	(M)-(acc) → (acc)	1	C, DC, Z	10 1010 0MMM MMMM
SWAPM M, m	Swape data from m to itself	1	None	10 1101 1MMM MMMM
SWAPM M, a	Swape data from m to acc	1	None	10 1101 0MMM MMMM
XORAM M, m	(M) xor (acc) → (M)	1	Z	10 1011 1MMM MMMM
XORAM M, a	(M) xor (acc) → (acc)	1	Z	10 1011 0MMM MMMM
XORLA I	Literal xor (acc) → (acc)	1	Z	11 1000 iiiiiiii

注：在 TM58PC10 中，不使用“RETI”指令。



8. 电气特性

8.1 绝对最大额定值

电源电压 ... $V_{SS}-0.3V$ to $V_{SS}+5.5V$ 存储温度 $-50^{\circ}C$ to $125^{\circ}C$

输入电压 ... $V_{SS}-0.3V$ to $V_{DD}+0.3V$ 工作温度 $0^{\circ}C$ to $70^{\circ}C$

8.2 直流电特性

Symbol	Parameter	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
		VDD	Conditions				
VDD	Operating Voltage	---		2.2		5.5	V
V_{IH}	Input High Voltage	5V	I/O Port	2		VDD	V
V_{IL}	Input Low Voltage	5V	I/O Port			0.8	V
I_{DD1}	Standby Current	5V	WDT disable		1		UA
			WDT enable		10		
I_{IL}	Input Leakage Current	5V	Vin=VDD, VSS		1		UA
I_{OH}	I/O Port Driving Current	5V	Voh=4.5V		9		mA
			Voh=4V		17		
			Voh=3.5V		23		
I_{OL}	I/O Port Sink Current	5V	Vol=0.5V		20		mA
			Vol=01V		35		
			Vol=1.5V		50		



8.3 交流电

Symbol	Parameter	Test Conditions		Min	Typ	Max	Unit
		VDD	Conditions				
f_{sys1}	System Clock	5V	LP Crystal mode	32		200	Khz
		3V		32	200		
f_{sys2}	System Clock	5V	NT Crystal mode	0.2		10	Mhz
		3V		0.2	10		
f_{sys3}	System Clock	5V	HS Crystal mode	10		20	Mhz
f_{sys4}	System Clock	5V	RC mode			6	Mhz
		3V				6	
T_{wdt}	Watchdog Timer	5V			20		mS
		3V			30		
T_{rht}	Reset Hold Time	5V			20		mS
		3V			30		